

戦略的創造研究推進事業 CREST におけるフランス ANR との日仏共同提案募集

●募集趣旨：

戦略的創造研究推進事業 CREST の 2024 年度募集において、フランス国立研究機構(ANR) と連携し、以下の研究領域で日仏共同提案を募集します。採択された場合、日本側グループは JST (CREST) から、フランス側グループは ANR からそれぞれ支援を受けます。

●共同研究提案を募集する研究領域：

・「ナノ物質を用いた半導体デバイス構造の活用基盤技術」(研究総括：齋藤 理一郎)

●応募方法：JST と ANR の両機関に共同研究提案書(英語、CREST-ANR 共通書式)を申請。

●募集期間：

ANR 側：2024 年 3 月 11 日(月)～6 月 7 日(金) 10:00 中央ヨーロッパ時間(夏時間)

※ANR の申請受付期間は、JST (CREST) と異なりますのでご注意ください。

※JST の申請受付は、今後 CREST 募集 HP にてご案内いたします。

※CREST への応募の際に、ANR に提出した日仏共同研究提案の内容を変更することはできません。

※日仏共同提案と通常の CREST 提案の両方を申請することはできません。

●詳細 URL：

[ANR] <https://anr.fr/en/call-for-proposals-details/call/bilateral-collaboration-anr-jst-crest-for-three-research-areas-nano-material-semiconductors/>

[CREST] <https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html>

●問合せ先：国立研究開発法人科学技術振興機構 戦略研究推進部 [募集専用]

E-mail：rp-info@jst.go.jp